

納米燒結銀漿

CT2700R7S

THE NEW VALUE FRONTIER



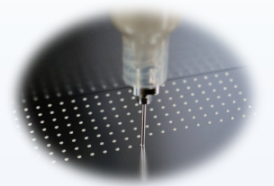
滿足半導體封裝需求的高導熱、導電晶片固晶材料

產品特性

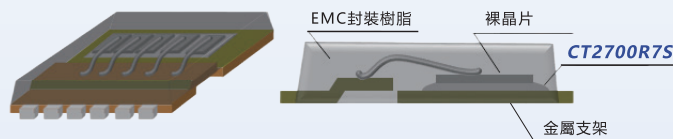
- 通過納米和微米級銀粉的金屬熔融達成高粘接強度
- 低電阻
 - 高導熱率 (200W/mK)
 - 利用獨特的樹脂分散體系實現低應力化、高耐熱、高可靠性 (即使在高達250°C高溫下也顯示出高粘接可靠性)

粘接工藝

- 可以使用現有設備無壓燒結
- 應用方法和既存銀漿一樣
- 可在200~250°C低溫燒結
- 可在空氣或氮氣環境下固化



應用點



【替代焊料】

- 替代高溫鉛焊料
- 替代AuSn焊料

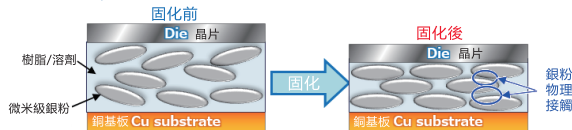
【器件】

- SiC/GaN功率器件 (TO封裝、功率模組)
- 表面發光二極體 (VCSEL)
- 高功率LEDs

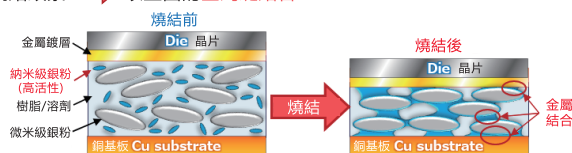
與傳統銀漿的比較

與傳統銀漿的比較

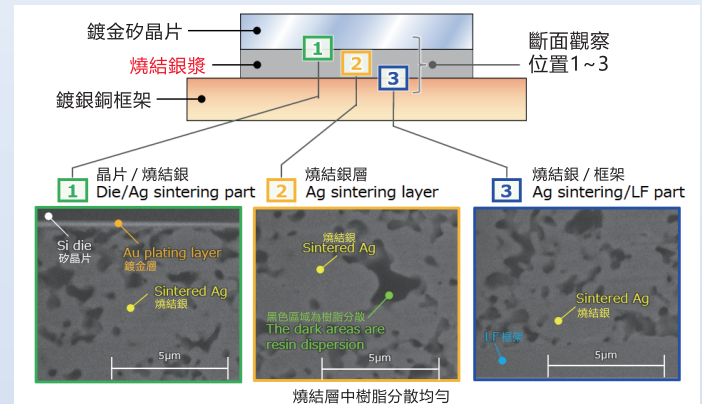
- 傳統銀漿 → 樹脂結合



- 燒結銀漿 → 以堅固的金屬鍵結合

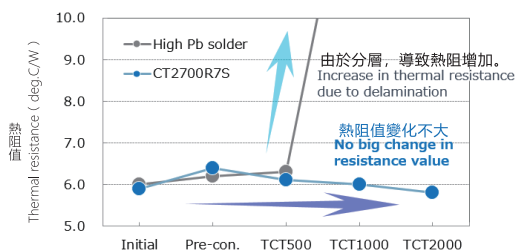


燒結層的斷面觀察



可靠性測試

【熱阻變化】-55°C/150°C冷熱循環試驗

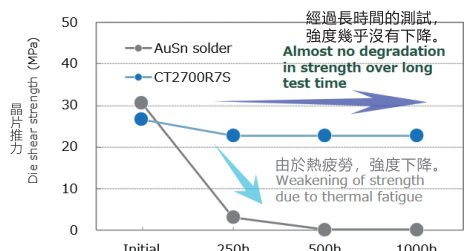


試驗條件 (客戶提供的資料)

PKG: HQFP 框架: 鍍銀銅框架
晶片: 6.0 x 6.0 x 0.4mm (背金) 預處理條件: MSL1 (260°C/10s, 3次)

推力強度變化

@ 250°C 高溫放置條件下



試驗條件 (社內試驗)

晶片: 4.0 x 4.0 x 0.3mm (背金) 框架: Pd-PPF 測定溫度: 260°C



代理商: 台灣銘奮電子科技有限公司

網址: www.fairfield.com.cn

銷售熱線: +886-07-2231869

+886-939603219